Цифровите системи извършват операции върху двоични променливи.

<u>Логическите елементи (схеми)</u> (Logic gates) са прости цифрови схеми, които имат един или повече двоични входове и един двоичен изход. Представят се със символ, показващ входовете и изхода. Обикновено входовете на символа са от ляво (или отгоре), а изхода – от дясно (или от долу). Входовете се означават с букви от началото на латинската азбука (A, B, C, ...) или с номерирана буква $(X_1, ...)$ $X_2, X_3, ...$), а за изход се използва Y. Връзката между входовете и изхода може да се опише чрез таблицата за <u>истинност</u> (truth table) или чрез <u>Булево</u> уравнение (Boolean equation). Таблицата за истинност показва състоянието на (OT изхода на схемата дясно), зависимост от състоянието на входовете (от ляво), като описва всички възможни входни комбинации. Булевото уравнение математическата връзка между двоичните променливи.

Изпълнявани логически функции:

Инверсия (HE)(inversion (NOT)),

И (AND), ИЛИ (OR), И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ, (NOR) и др. Едно-входови:

Схема HE (NOT gate),

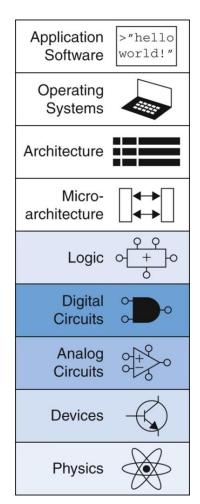
Повторител (buffer)

Дву-входови:

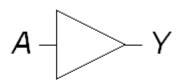
AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR

Много-входови:

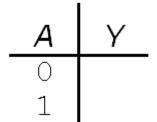
- С повече от два входа



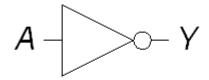
NOT $A = \sum_{Y = \overline{A}}$



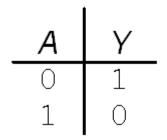
$$Y = A$$



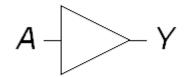
NOT



$$Y = \overline{A}$$

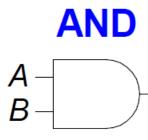


BUF



$$Y = A$$

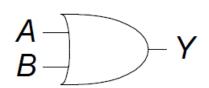
Α	Υ
0	0
1	1



$$Y = AB$$

Α	В	Υ
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

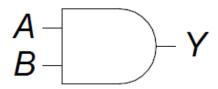




$$Y = A + B$$

Α	В	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

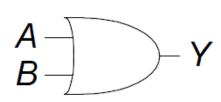
AND



$$Y = AB$$

Α	В	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

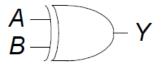
OR



$$Y = A + B$$

Α	В	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

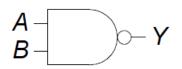
XOR



$$Y = A \oplus B$$

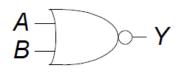
Α	В	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

NAND



$$Y = \overline{AB}$$

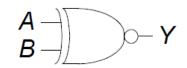
NOR



$$Y = \overline{A + B}$$

Α	В	Υ
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

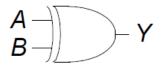
XNOR



$$Y = \overline{A \oplus B}$$

Α	В	Υ
0	0	_
0	1	
1	0	
1	1	

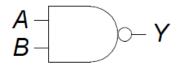
XOR



$$Y = A \oplus B$$

Α	В	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

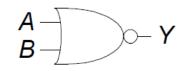
NAND



$$Y = \overline{AB}$$

Α	В	Υ
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

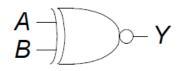
NOR



$$Y = \overline{A + B}$$

Α	В	Υ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

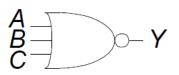
XNOR



$$Y = \overline{A \oplus B}$$

Α	В	Υ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

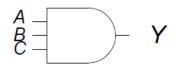
NOR3



$$Y = \overline{A + B + C}$$

Α	В	С	Υ
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

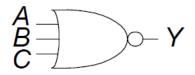
AND3



$$Y = ABC$$

Α	В	С	Υ
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

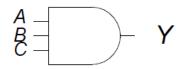
NOR₃



$$Y = \overline{A+B+C}$$

Α	В	С	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND3



$$Y = ABC$$

Α	В	С	Υ
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

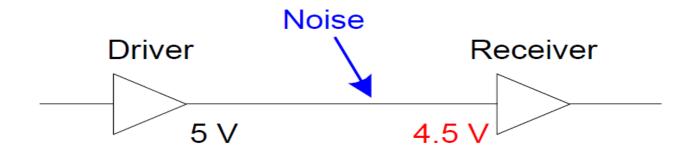
Логически нива.

Цифровите системи използват дискретни променливи. Но тези променливи се реализират чрез непрекъснати физически величини като, например, електрическото напрежение. Нека A е двоична променлива (A=0 или A=1).

Нека 0V (GND) отговаря на A=0 и +5V (V_{DD} — захр. напрежение) отговаря на A=1. В реалните системи тези нива практически не се получават, поради наличието на шум. И ако при измерени +4.95V можем да приемем A=1, а при 0.05V — A=0, то какво може да се каже при +4.3V; +3.3V; +2.500V; +2.3V? — Отговорът не винаги е еднозначен. Това налага приемане на определени правила:

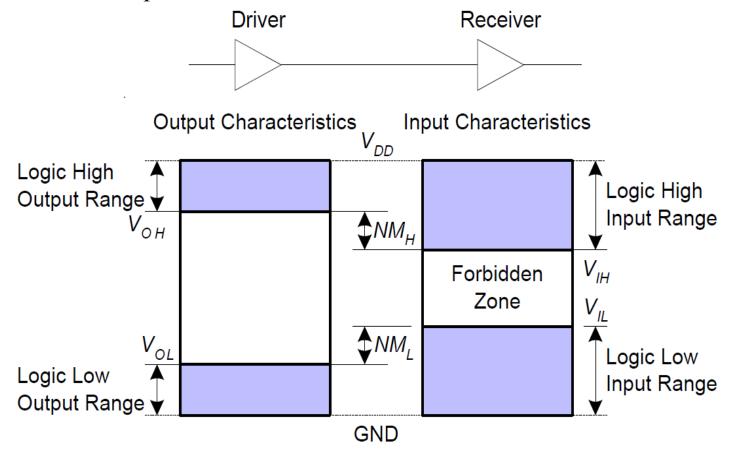
- 1. Обхват на напреженията отговарящи на 1 и 0;
- 2. Различен обхват по отношение на входа и изхода заради шума.

Какво е <u>шум</u>? — Това са нежелани, случайни процеси (смущения), дължащи се съпротивлението на проводниците, близост с други проводници, по които тече ток, физическата природа на токовите носители. Пример:

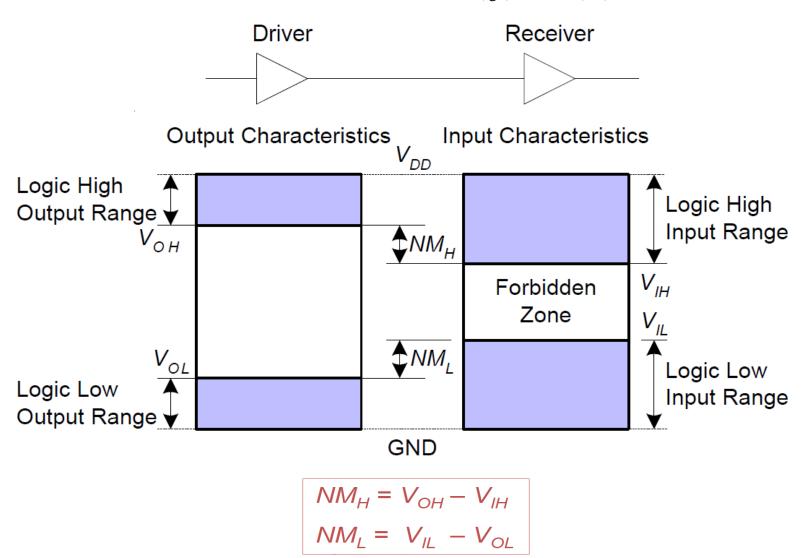


Решението е в приемането на следните ограничения (Static Discipline):

- При подаване на логически валидни входни сигнали всеки логически елемент трябва да дава логически валиден изходен сигнал;
- За представяне на дискретните стойности (0/1) да се използва ограничен обхват от напрежения.



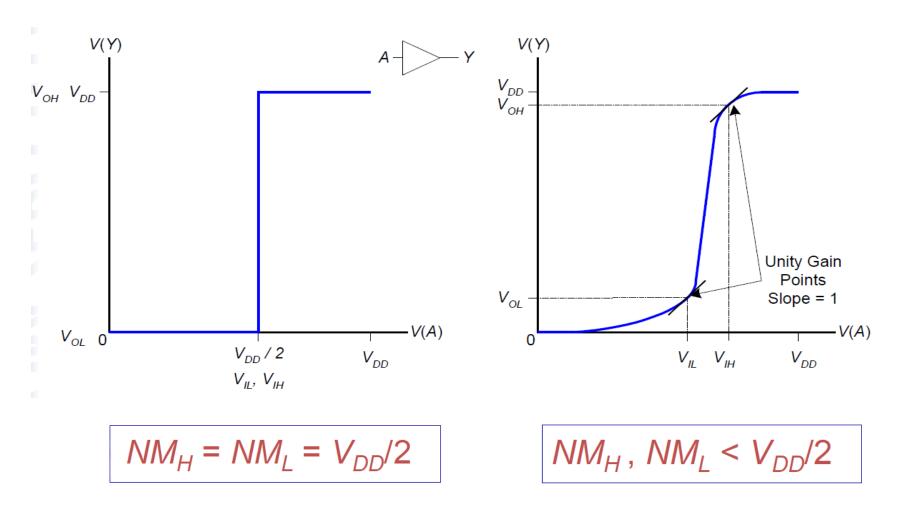
NM (Noise Margins) — шумови граници ($NM_{H(igh)}$, $NM_{L(ow)}$)



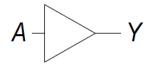
Постояннотокова предавателна функция (DC Transfer Characteristics)

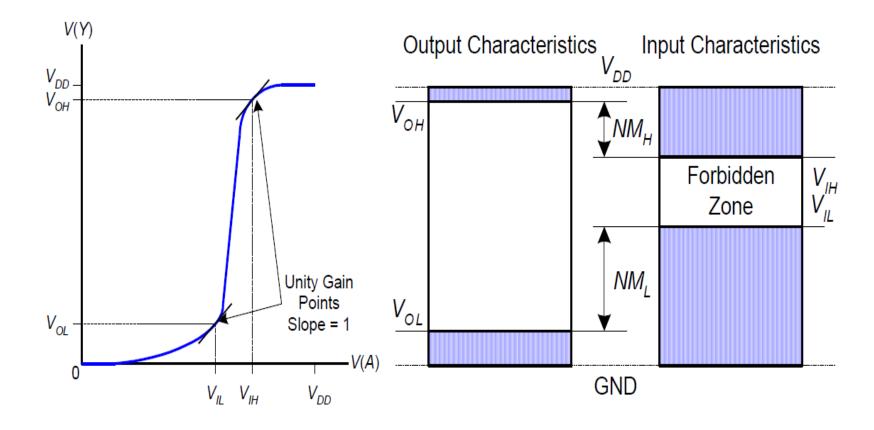
Ideal Buffer:

Real Buffer:



Постояннотокова предавателна функция (DC Transfer Characteristics)





Захранващи напрежения (V_{DD})

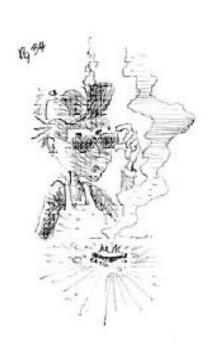
През 70-те и 80-те години на 20-ти век — $V_{DD} = 5 \text{ V}$ След това V_{DD} постоянно намалява — 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, ...

- за да не се прегряват транзисторите;
- за да се пести енергия;
- за да се увеличи бързодействието.

Да се внимава при свързването на ИС, работещи с различни захранващи напрежения!

Чиповете работят, защото съдържат вълшебен дим! Доказателство:

Ако вълшебният дим излети, чипът престава да работи...



Логически семейства.

Logic Family	V_{DD}	V_{IL}	$V_{I\!H}$	V_{OL}	V_{OH}
TTL	5 (4.75 - 5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
CMOS	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
LVTTL	3.3 (3 - 3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
LVCMOS	3.3 (3 - 3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7

TTL — Транзисторно-транзисторна логика.

CMOS – Комплементарна MOS логика.

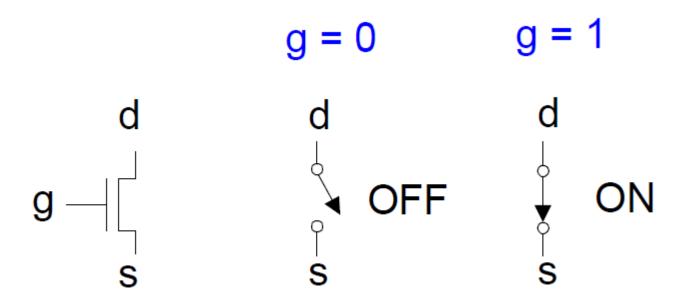
LVTTL – Low Voltage TTL.

LVCMOS – Low Voltage CMOS.

Транзистори.

Логическите елементи са изградени от транзистори.

Транзисторът като 3-изводен ключ (3-ported voltage-controlled switch) Връзката между 2 от изводите зависи от напрежението на 3-тия. (d и s са свързани (ON), когато g e 1).

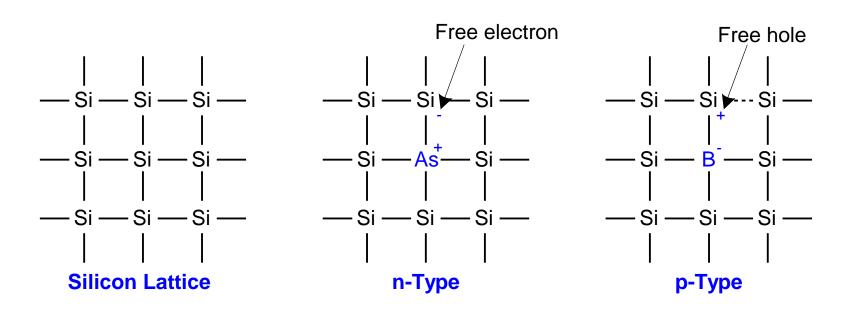


<u>Силициеви MOS транзистори.</u>

Транзисторите са направени от силиций (silicon), който е полупроводник.

Чистият силиций е лош проводник при стайна температура (няма свободни заряди). Примесният силиций е добър проводник (наличие на свободни заряди).

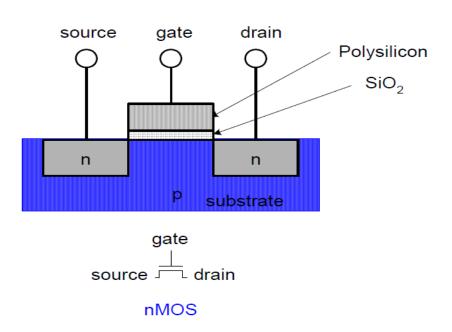
- n-type (свободни отрицателни (negative) заряди, електрони).
- p-type (свободни положителни (positive) заряди, дупки).



Силициеви MOS транзистори.

Metal oxide silicon (MOS) transistors:

- Polysilicon (used to be **metal**) gate
- Oxide (silicon dioxide) insulator
- Doped silicon



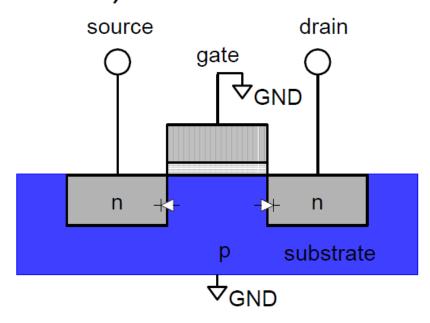
Силициеви MOS транзистори.

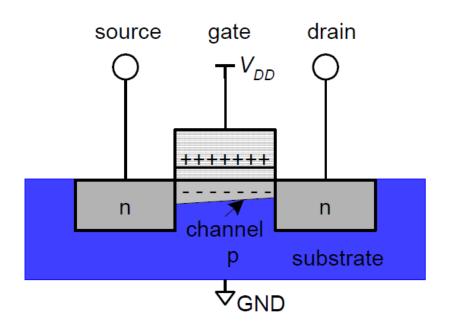
Gate = 0

Gate = 1

OFF (no connection between source and drain)

ON (channel between source and drain)

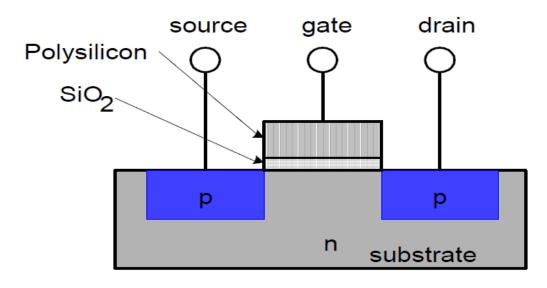




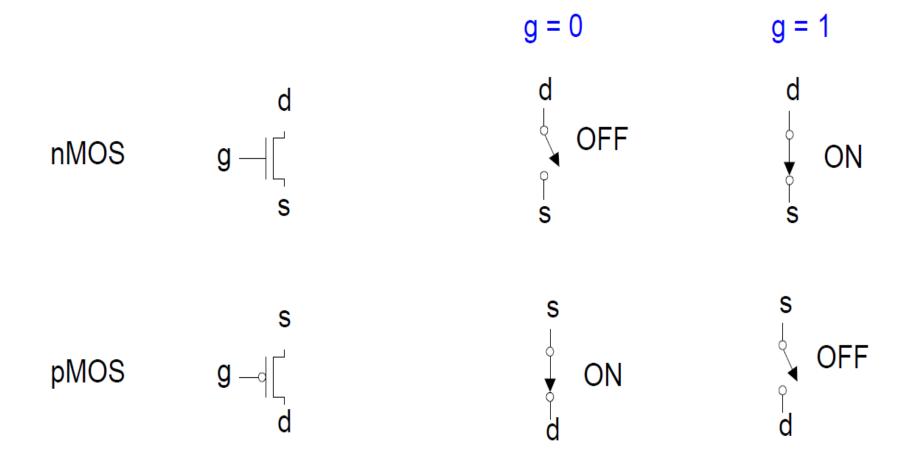
<u>Силициеви МОЅ транзистори.</u>

pMOS transistor is opposite

- ON when Gate = 0
- OFF when Gate = 1

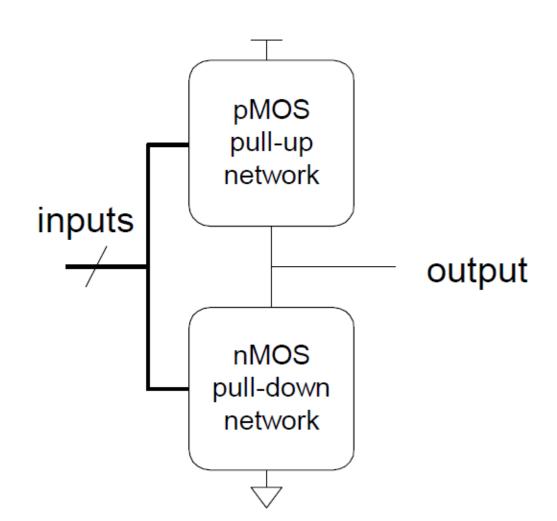


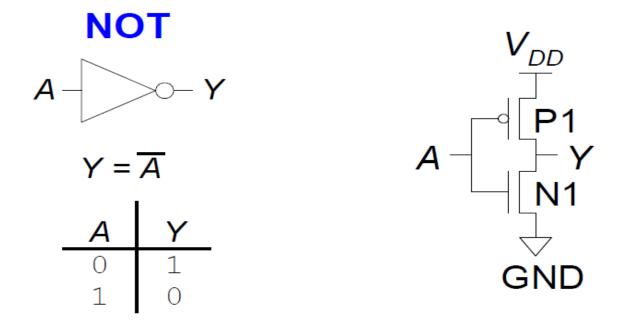
<u>Силициеви MOS транзисторни ключове.</u>



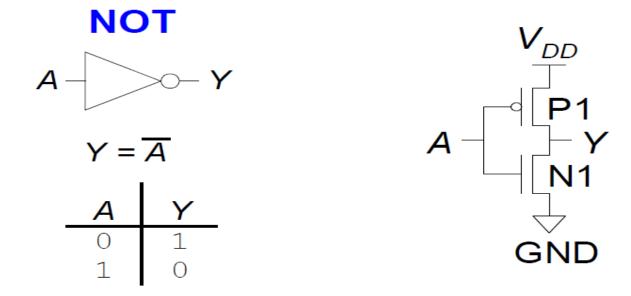
<u>Силициеви МОЅ транзисторни ключове.</u>

- **nMOS**: предава добре 0-те, за това сорсът се свързва към GND.
- **pMOS:** предава добре 1-те, за това сорсът се свързва към V_{DD} .



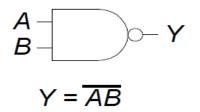


A	P1	N1	Y
0			
1			

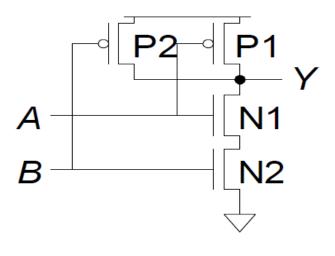


A	P1	N1	Y
0	ON	OFF	1
1	OFF	ON	0



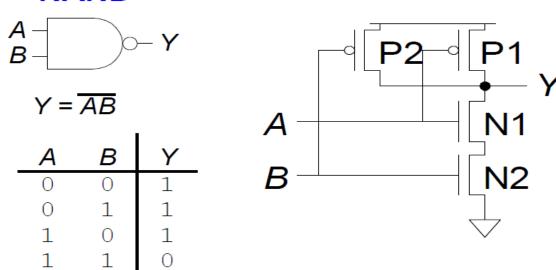


Α	В	Y
0	0	1
O	1	1
1	Ο	1
1	1	0



\overline{A}	B	P1	P2	N1	N2	Y
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

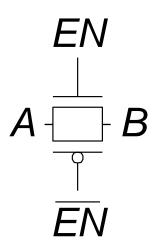




\overline{A}	B	P1	P2	N1	N2	Y
0	0	ON	ON	OFF	OFF	1
0	1	ON	OFF	OFF	ON	1
1	0	OFF	ON	ON	OFF	1
1	1	OFF	OFF	ON	ON	0

CMOS предвателен елемент (Transmission gate).

- nMOS предава 1-те лошо.
- pMOS предава 0-те лошо.
- Transmission gate е по-добър ключ:
 - предава както 0, така и 1-ца добре.
- Когато EN = 1, ключът е ON:
 - $\overline{EN} = 0$ и A е свързано с B;
- Когато EN = 0, ключът е OFF:
 - A не е свързано с B.



<u>CMOS логически елементи – консумирана мощност.</u>

Мощност = Енергията, консумирана за единица време.

— Динамична консумирана мощност — за зареждане на капацитета C на гейта на транзистора до напрежение V_{DD} с честота \boldsymbol{f} ;

$$P_{dynamic} = \frac{1}{2}CV_{DD}^2 f$$

— Статична консумирана мощност — заради захранващия (утечен) ток I_{DD} .

$$P_{static} = I_{DD}V_{DD}$$

> Пълна консумирана мощност:

$$P_{total} = \frac{1}{2}CV_{DD}^2f + I_{DD}V_{DD}$$